HL-Laser: Temperaturabhängigkeit

Betriebstemperatur hat Einfluss auf die Laser-Emission:

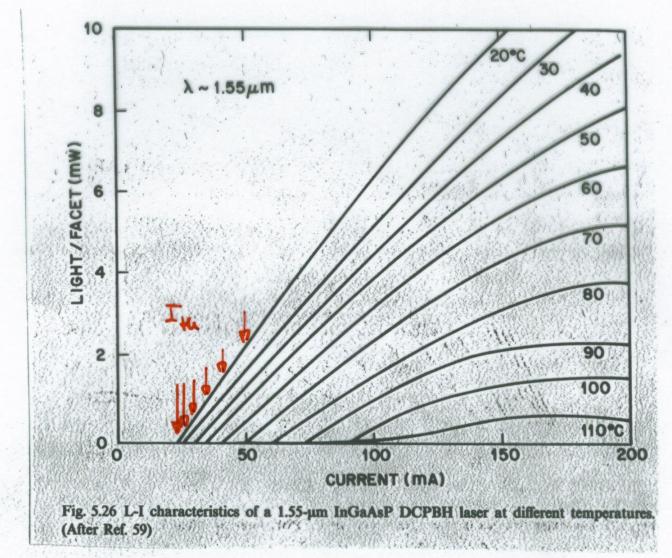
- 1. Schwellstrom steigt mit steigender Temperatur
 - a) f_e und f_h verbreitern sich => f_e + f_h > 1 erfordert höhere Ladungsträgerdichte => höherer Schwellstrom
 - b) höhere Energie der Ladungsträger und damit höherer Leckstrom
 - c) höhere Energie der Ladungsträger => erhöhte Augerrekombination

insgesamt ergibt sich empirisch ein exponentieller Anstieg T_0 ist die charakteristische Temperatur

$$J_{th}=J_{th}^{0}e^{rac{T}{T_{0}}}$$

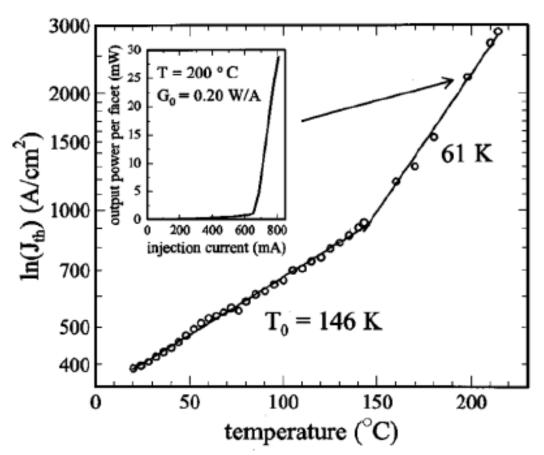
- 2. Intensität sinkt mit steigender Temperatur
- 3. Emissionswellenlänge verschiebt

Temperaturabhängigkeit Schwellstromdichte



DCPBH =double channel planar buried heterostrutrure

Temperaturabhängigkeit Schwellstromdichte

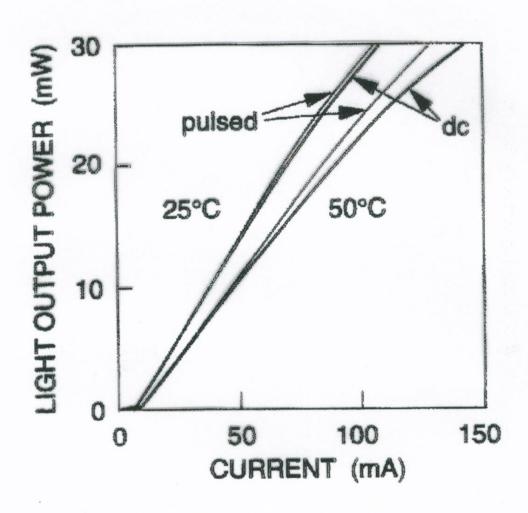


$$J_{th} = J_{th}^0 e^{\frac{T}{T_0}}$$

- Charakteristische Temperatur ist nicht unbedingt konstant
- Dominierender
 Mechanismus
 bestimmt T₀ und
 kann je nach T Bereich wechseln
- Kleines T₀ gewünscht (geringe Temperaturabhängigkeit)

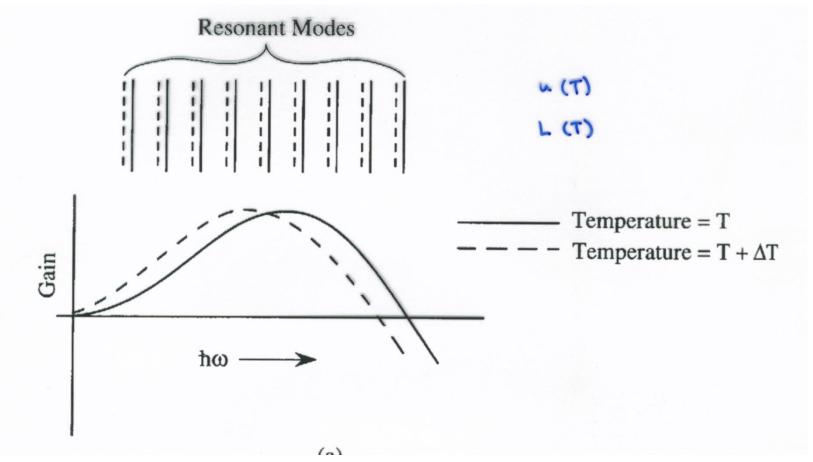
Abbildung 1.11.1: Schwellenstromdichte eines InGaAs/AlGaAs Lasers in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterhalb von $T=150^{\circ}\text{C}$ kann der Verlauf durch ein T_0 von 146 K beschrieben werden, für größere Temperaturen fällt T_0 auf 61 K. Der Inset zeigt die Kennlinie des Lasers bei einer Temperatur von 200°C .

Temperaturabhängigkeit Intensität



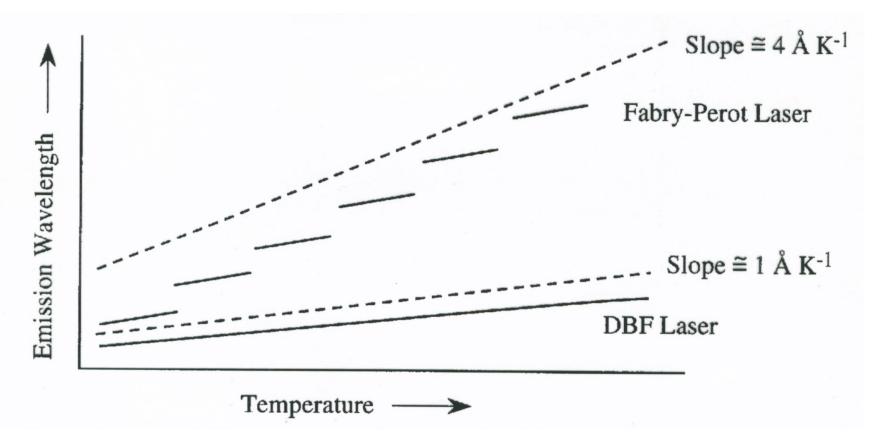
- Für einen gegebenen
 Strom sinkt die optische
 Ausgangsleistung
- Mit steigender Temperatur sinkt die interne Quanteneffizienz
- Kleines T₀ bedeutet auch hier geringe
 Temperaturabhängigkeit

Temperaturabhängigkeit Emissionswellenlänge



- Position der Moden verschiebt (Längenausdehnung des Resonators nicht relevant, aber Änderung des Brechungsindexes)
- Position des Gain-Spektrums verschiebt Bandlücke wird kleiner

Temperaturabhängigkeit Emissionswellenlänge



- Steigende Temperatur sorgt für eine Rotverschiebung
- Für DFB-Laser nur Verschiebung der Mode durch Änderung des Brechungsindex mit der Temperatur
- Für FB springt der Laser mit steigendem T zu niederenergetischeren Moden

Laserdiode: dynamische Eigenschaften

- Bisher nur statische Eigenschaften behandelt (I = const. oder langsam variiert)
- Für die Signalübertragung ist es aber wichtig, die Laserintensität zeitlich zu modulieren.
- Für hohe Datenraten ist natürlich eine schnelle Modulation notwendig.
 Damit ergeben sich zwei Fragen:
 - a) Wie schnell kann ich die Laserintensität bei Groß- und Kleinsignalmodulation ändern? Was begrenzt die Laserresponsezeit?
 - b) Was passiert mit der Linienbreite unter Modulation?

Modulationsarten für Laserdioden

Es gibt drei grundsätzliche Arten, einen Laser zu modulieren:

Großsignalmodulation:

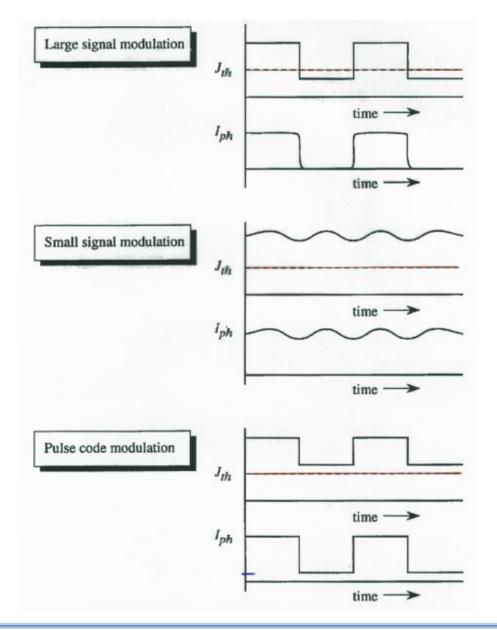
Laser wird so beschaltet, dass er tatsächlich aus und eingeschaltet wird (langsam, ~ 10 ns, wie LED)

Kleinsignalmodulation:

Laser wird oberhalb der Schwelle mit einem kleinen AC-Signal moduliert. Damit sind die höchsten Modulationsfrequenzen realisierbar (bis 50 GHz). Liefert Informationen über die fundamentalen Grenzen des Lasers.

Pulse Code Modulation (PCM):

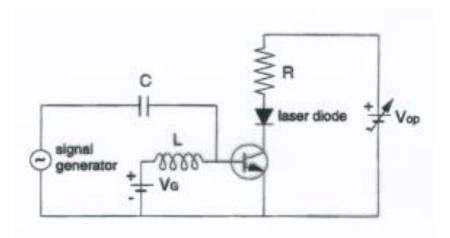
Digitale Pulsfolge, bei der der Laser immer oberhalb der Schwelle bleibt. D. h. auch im "Low"-Zustand wir Licht emittiert.



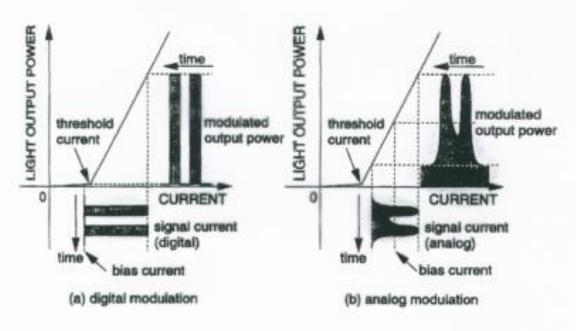
Modulationsarten für Laserdioden

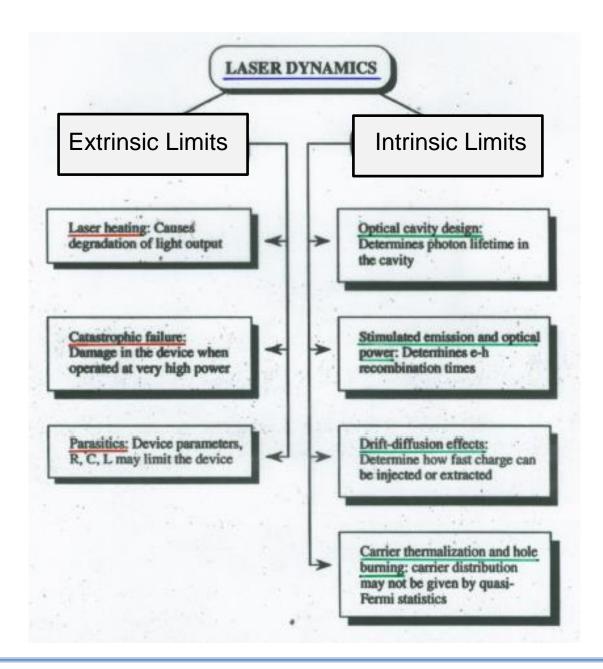
- Modulation des Stroms durch den Laser resultiert in einer Modulation des Photonenstroms
- Das geht nicht zu beliebig hohen Frequenzen!
- Signalform wird eventuel verzerrt

Laserdioden: Modulation



- Modulation des Stroms durch geeignete Beschaltung
- Digitale oder analoge Modulation möglich
- Lineare Strom-Intensitätskennlinie ermöglicht im analogen Fall im Prinzip eine unverzerrte Signalwiedergabe

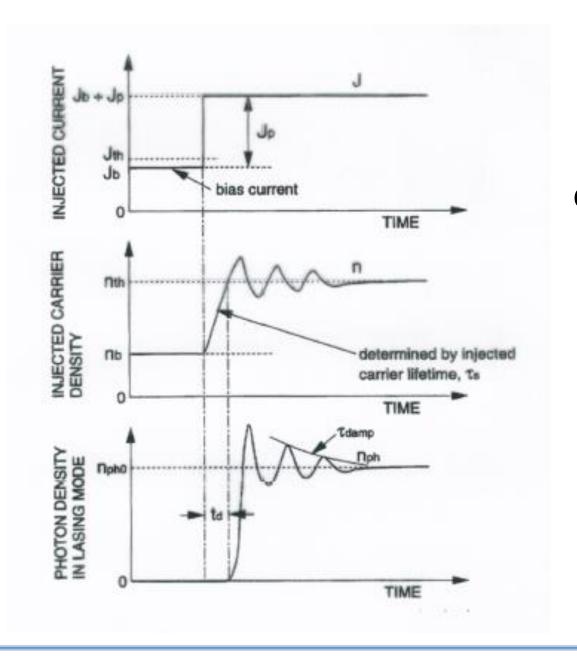




Grenzen für die Laserdynamik

Großsignalmodulation/Einschalten eines Lasers

- Anlegen eines rechteckigen Strompulses, vor dem Puls ist die Ladungsträgerdichte im aktiven Bereich so gut wie Null
- Einschalten des Stroms => Ladungsträgerdichte erhöht sich => Gain steigt
- Solange der Gain kleiner als die Resonatorverluste ist, werden nur sehr wenig Photonen aus dem Laser emittiert => für eine Zeit t_d (delay time) werden keine Photonen aus dem Bauelement emittiert
- Erreicht die Ladungsträgerdichte n_{th}, so beginnt die stimulierte Emission
- Die Ladungsträgerdichte steigt jedoch über n_{th} hinaus an. Die daraus resultierende hohe Photonendichte führt zu einer Reduktion von n.
- Nach dem Einschalten gibt es Oszillationen in der Ladungsträgerdichte und dem Photonenstrom



Großsignalmodulation/ Einschalten eines Lasers

- Wovon hängt t_d und τ_{damp} ab?
- Wie groß ist die Oszillationsfrequenz?

Großsignalmodulation/Einschalten: Ratengleichung

Die Veränderung der Dichte in der aktiven Schicht wird durch folgende Differentialgleichung beschrieben:

$$\frac{dn_{2D}}{dt} = \frac{J}{e} - \frac{n_{2D}}{\tau} - R_{stim}$$

mit τ = gesamte Rekombinationszeit durch alle Kanäle

 Wenn der Strom von J = 0 auf J verändert wird, kann die stimulierte Emission vernachlässigt werden, solange n < n_{th}; dann kann die Gleichung von der Startdichte n_{2D}(i) bis zur Enddichte n_{2D}(f) integriert werden:

$$t_{f} = \tau \ln \frac{J - \frac{en_{2D}(i)}{\tau}}{J - \frac{en_{2D}(f)}{\tau}}$$

mit t_f = Zeit bis zum Erreichen von $n_{2D}(f)$

Großsignalmodulation/Einschalten: Ratengleichung

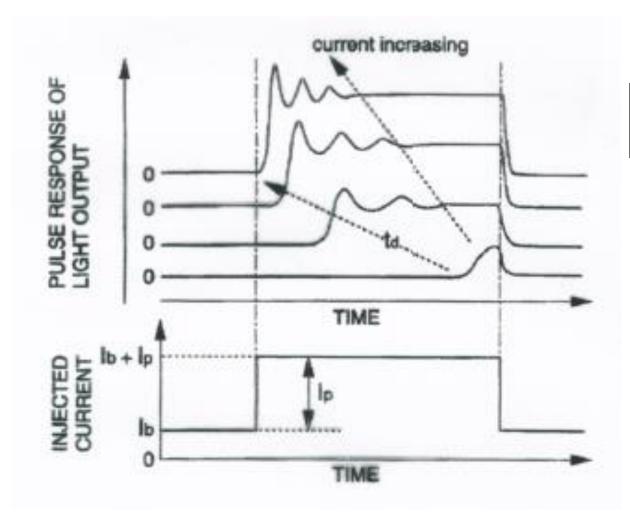
$$t_{f} = \tau \ln \frac{J - \frac{en_{2D}(i)}{\tau}}{J - \frac{en_{2D}(f)}{\tau}}$$

Die Photonenemission setzt ein, wenn gilt $n_{2D}(f) = n_{th}$ Wenn man noch $n_{2D}(i) = 0$ annimmt, ergibt sich für $t_{f,th}$

$$t_{d} = \tau \ln \frac{J}{J - \frac{en_{th}}{\tau}} = \tau \ln \frac{J}{J - J_{th}}$$

- t_d liegt in der etwa bei τ
- Wenn nichtstrahlende Prozesse zu vernachlässigen sind, ist $\tau = \tau_r$
- t_d sinkt mit steigendem J (0,1 τ für J=10 J_{th})
- bis richtig Licht aus dem Laser kommt vergeht zusätzlich noch einmal Zeit (~τ)

Großsignalmodulation/Einschalten: Verzögerung



$$t_d = \tau \ln \frac{J}{J - J_{th}}$$

nur knapp die Schwelle zu überschreiten sorgt für sehr langes t_d

- Schlüsselkennzahl für die Laserperformance (obwohl bei der Datenübertragung so nicht eingesetzt)
- Liefert wichtige Einsichten in die Physik des Lasers und wie das Design optimiert werden kann
- Es wird einem hohen Injektionsstrom ein kleines sinusförmiges zeitabhängiges Stromsignal überlagert

$$J = \overline{J} + \widetilde{J}e^{i\omega t}$$

 Dies verursacht folgende Änderungen in der Ladungsträgerdichte und der Photonendichte

$$n_{2D} = \overline{n}_{2D} + \widetilde{n}_{2D}e^{i\omega t} = \overline{n}_{2D} + \Delta n_{2D}$$

$$S_m = \overline{S}_m + \widetilde{S}_m e^{i\omega t} = \overline{S}_m + \Delta S_m$$

 Beschreibung durch die gekoppelten Differentialgleichungen für Photonenzahl und die Ladungsträgerdichte

$$\frac{dS_{m}}{dt} = \left[\Gamma g(n_{2D}, E_{m}) - \alpha_{c}\right] \frac{c}{n_{r}S_{m}} + \beta R_{sp}(n_{2D})$$

$$\frac{dn_{2D}}{dt} = \frac{J}{e} - \frac{J_{nr}}{e} - R_{sp}(n_{2D}) - \frac{c}{n_{r}} \sum_{m} \Gamma g(n_{2D}, E_{m}) S_{m}$$

- Der nichtstrahlende Anteil am Strom J soll zunächst vernachlässigt werden
- Weiter gehen wir davon aus, dass Gain und spontane Emissionsrate linearisiert betrachtet werden können (Taylor-Reihe, 1. Ordnung)

$$g(\overline{n}_{2D} + \Delta n_{2D}, E_m) \cong g(\overline{n}_{2D}, E_m) + \frac{\partial g(\overline{n}_{2D}, E_m)}{\partial n_{2D}} \Delta n_{2D}$$

$$R_{sp}(\overline{n}_{2D} + \Delta n_{2D}) \cong R_{sp}(\overline{n}_{2D}) + \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} \Delta n_{2D}$$

 Einsetzen in die gekoppelten Differentialgleichungen und nur behalten von Termen in 1. Ordnung von ∆n und ∆S (nur eine Mode betrachtet, Laser wird bei hohen Strömen betrieben)

$$\tilde{S}(i\omega - \Gamma g \frac{c}{n_r} + \alpha_c \frac{c}{n_r}) = \tilde{n}_{2D} \left(\Gamma \frac{\partial g}{\partial n_{2D}} \frac{c}{n_r} \overline{S} + \beta \frac{\partial R_{sp}(n_{2D})}{\partial n_{2D}} \right)$$

$$\tilde{n}_{2D} \left(i\omega + \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \Gamma \frac{\partial g}{\partial n_{2D}} \frac{c}{n_r} \overline{S} = \frac{\tilde{J}}{e} - \Gamma g \frac{c}{n_r} \tilde{S}$$

Eliminieren von n führt auf

$$\begin{split} \tilde{S}(\Gamma \frac{g(\overline{n}_{2D})c}{n_r} + \frac{i\omega\gamma}{\xi} \left\{ i\omega - \Gamma g(\overline{n}_{2D} - \alpha_c) \right\} \frac{c}{n_r}) &= \frac{\tilde{J}}{e} \\ \text{mit } \gamma &= \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \Gamma \frac{c}{n_r} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} \overline{S} \\ \xi &= \beta \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \Gamma \frac{c}{n_r} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} \overline{S} \end{split}$$

$$\tilde{S}\left(\Gamma \frac{g(\overline{n}_{2D})c}{n_r} + \frac{i\omega\gamma}{\xi} \left\{ i\omega - \Gamma g(\overline{n}_{2D} - \alpha_c) \right\} \frac{c}{n_r}\right) = \frac{\tilde{J}}{e}$$

Unter Verwendung der Photonenlebensdauer im Resonator

$$\tau_{Ph} = \frac{1}{\Gamma / n_r g(\overline{n}_{2D})} = \frac{n_r}{\alpha_c c}$$

lässt sich die Übertragungsfunktion wie folgt schreiben:

$$\frac{\tilde{S}}{\tilde{J}} = R(\omega) = \frac{\omega_r^2}{(\omega_r^2 - \omega^2) + i\omega\gamma}$$

$$\text{mit } \omega_r^2 = \frac{\beta}{\tau_{Ph}} \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \frac{\Gamma c\overline{S}}{n_r \tau_{Ph}} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$

Kleinsignalmodulation: Resonanzfrequenz

$$\omega_r^2 = \frac{\beta}{\tau_{Ph}} \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \frac{\Gamma c \overline{S}}{n_r \tau_{Ph}} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$

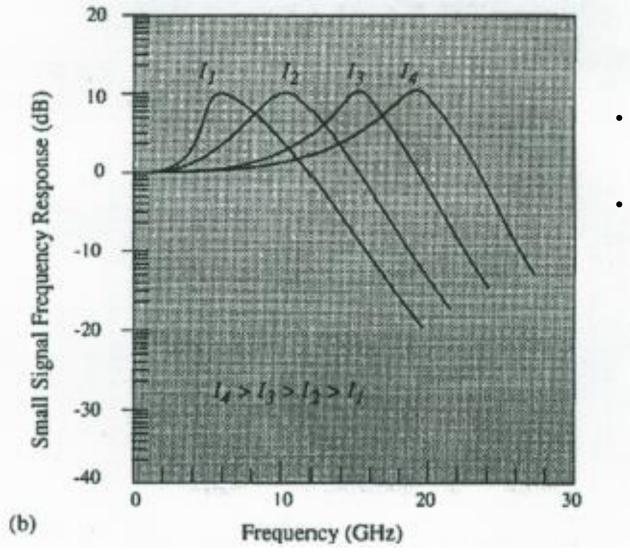
Wenn der Laser mit hohen Strömen betrieben wird, kann man $R_{\rm sp}$ vernachlässigen (stimulierte Emission dominiert). Dann ergibt sich für die Resonanzfrequenz

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Gamma c \overline{S}}{n_r \tau_{Ph}}} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$

Die Dämpfungsrate γ in der Übertragungsfunktion kann wie folgt geschrieben werde:

$$\gamma = \frac{\partial R_{sp}(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}} + \omega_r^2 \tau_{Ph}$$

Kleinsignalmodulation: Übertragungsfunktion



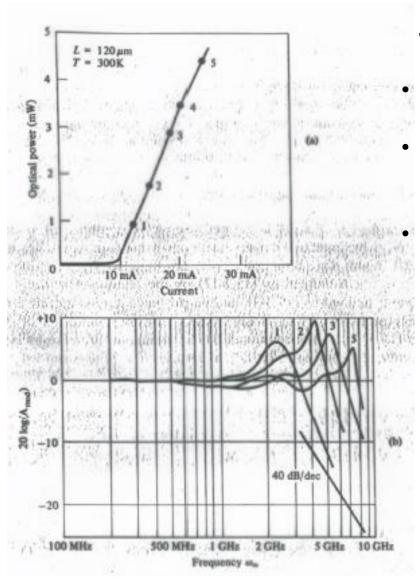
- Je höher der Strom, desto höher die Resonanzfrequenz
- Auch der 3 dB Punkt verschiebt sich für höhere Ströme zu höheren Frequenzen

Kleinsignalmodulation: Diskussion Resonanzfrequenz

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Gamma c \overline{S}}{n_r \tau_{Ph}}} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$

- Hohe mittlere Photonenzahl gibt hohe Resonanzfrequenz
 - $S \sim J-J_{th}$
 - je höher der mittlere Strom desto größer die Resonanzfrequenz
 - hoher Strom kann Bauelement schädigen, also nicht beliebig erhöhbar
 - Absenken des Schwellstroms führt auch zu Erhöhung der Resonanzfrequenz
- Nichtstrahlender Strom reduziert die Bauelementleistung auf zwei Arten:
 - Bei gleichem Gesamtstrom ist die Photonendichte kleiner => Resonanzfrequenz sinkt
 - Dämpfung γ nimmt zu

$$\gamma_{gesamt} = \gamma_{strahlend} + \frac{1}{e} \frac{\partial J(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$



Resonanzfrequenz: Stromabhängigkeit

- Je höher der Strom, desto höher die Resonanzfrequenz
- Theoretisch sollte gelten

$$f_r \sim \sqrt{S} \sim \sqrt{J - J_{th}}$$

Passt auch bei Vergleich mit den Graphen ganz gut

Kleinsignalmodulation: Resonanzfrequenz Diskussion

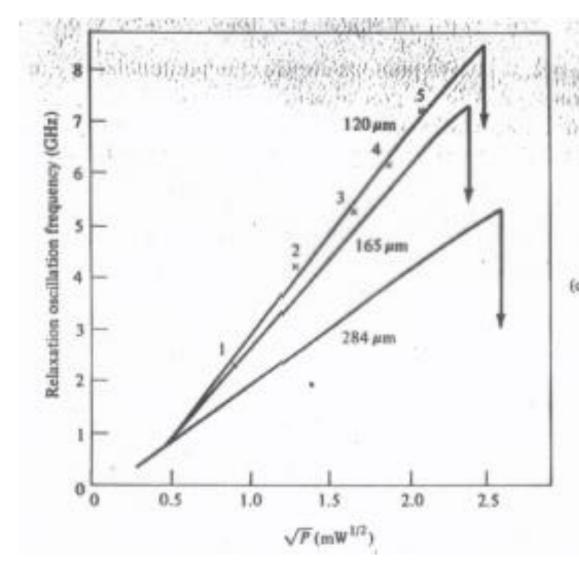
$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Gamma c \overline{S}}{n_r \tau_{Ph}}} \frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$

- Kleine Photonenlebensdauer im Resonator gibt hohe Resonanzfrequenz
 - kurze Laser!!
 - allerdings steigt dann g_{th}, da ja die Resonatorverluste ausgeglichen werden müssen
 - Damit steigt der Schwellstrom => kontraproduktiv
 - gibt optimale Resonatorlänge (für QW-Laser im Bereich von 100 μm)
- Großer differentieller Gain erlaubt hohe Resonanzfrequenz

$$\frac{\partial g(\overline{n}_{2D})}{\partial n_{2D}}$$
 = "differentieller Gain""

- QW bzw. verspannte QW-Strukturen haben eine höheren diff. Gain (Zustandsdichte)
- Durch die schmalere Zustandsdichte ändert sich der Gain bei Erhöhung von n stärker, da nicht so viel Ladungsträger bei Energien landen die nicht zum Gain der Hauptmode beitragen

Kleinsignalmodulation: Resonanzfrequenz Diskussion



- Gerechnete
 Resonanzfrequenz als
 Funktion der optischen
 Ausgangsleistung
- Je kürzer der Laser je besser
- Kurven brechen ab, wenn das Bauelement geschädigt wird
- QW-Laser arbeiten heute standardmäßig bei etwa 40 GHz
- Resonanzfrequenz ist auch die Frequenz mit der die Oszillationen nach dem Einschalten schwingen

Linienbreite Laseroutput

- Datenübertragung eine ganz wichtige Anwendung, insbesondere für modulierte Signale
- Fenster für Übertragung durch eine Glasfaser bei 1,55 μm ~30 nm => kleine Wellenlängen für Multiplexing
- Kohärente Detektionsschemata erfordern noch deutlich schmalere Linienbreiten
- Verschiedene Faktoren beeinflussen die Linienbreite
 - statisch oder moduliert ist sicherlich ein Unterschied

Linienbreite Laseroutput

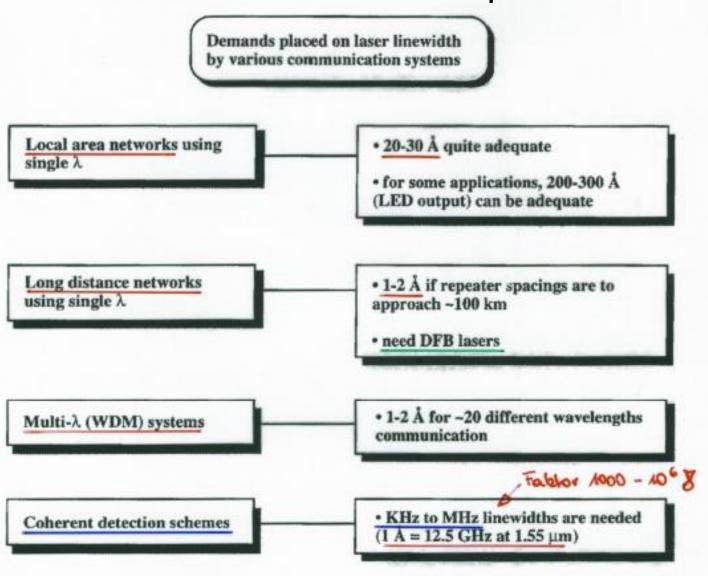


Figure 11.15: Important linewidth requirements for various optical communication schemes.

Linienbreite Laseroutput

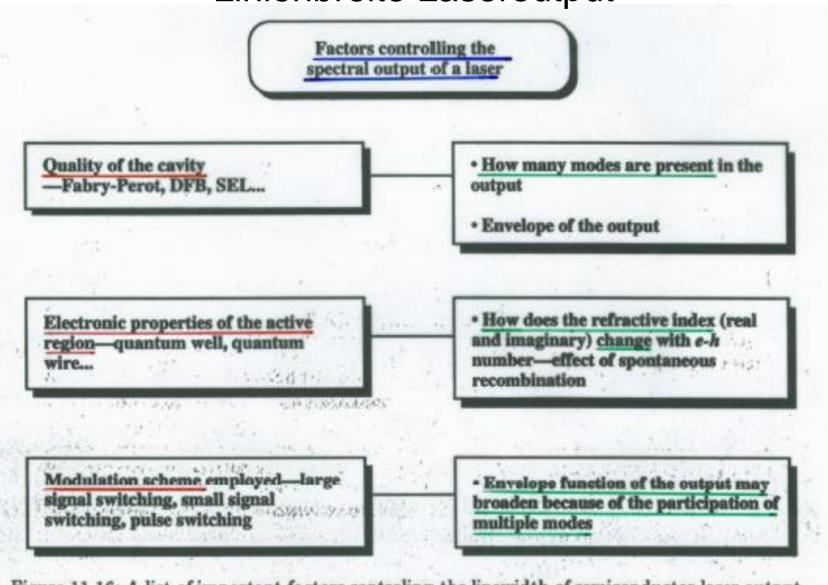


Figure 11.16: A list of important factors controling the linewidth of semiconductor laser output.

Linienbreite: Einfluss Resonator

- Welche Breite hat ein einzelner Mode (DFB-Laser oder FB-Laser)? D. h. wenn man einen Monomode Laser hat
- Die Breite der Absorption einer Mode, also den Frequenzfenster in dem die Mode laufen kann, wird durch die Heisenbergsche Unschärferelation bestimmt:

$$\Delta \omega \approx \frac{1}{\tau_{Ph}} \approx \frac{c |\ln R|}{L n_r}$$

- Für typische Laserresonatoren liegt die Resonanz im THz-Bereich
- Bei 1,55 µm entspricht 1 THz ~ 8 nm
- Die Absorptionsbreite sorgt nicht für eine kleine Linienbreite
- Es müssen zusätzliche Prozesse eine Rolle spielen

Linienbreite: spontane Emission und α_{enh}

- Die spontane Emission hat keine Phasenbeziehung zu den Photonen die über stimulierte Emission abgegeben werden
- Durch die fehlende Kopplung an die Energie der "Leitphotonen" scheint intuitiv klar zu sein, dass die spontane Emission eine wichtige Ursache für die Linienbreite sein kann
- Die Ladungsträgerinjektion in die aktive Zone beeinflusst sowohl den Realwie auch den Imaginärteil des Brechungsindex
- Der Imaginärteil ist mit dem Gain verknüpft
- Der Realteil mit der Position der Mode => wenn sich dieser verändert, ändert sich die Position der Mode
- Zufällige Schwankungen in der Ladungsträgerdichte führen zu einer Verbreiterung der Emission

Linienbreite: α_{enh}

 Die Änderung des Realteils des Brechungsindexes ist mit der Änderung im Gain wie folgt verknüpft

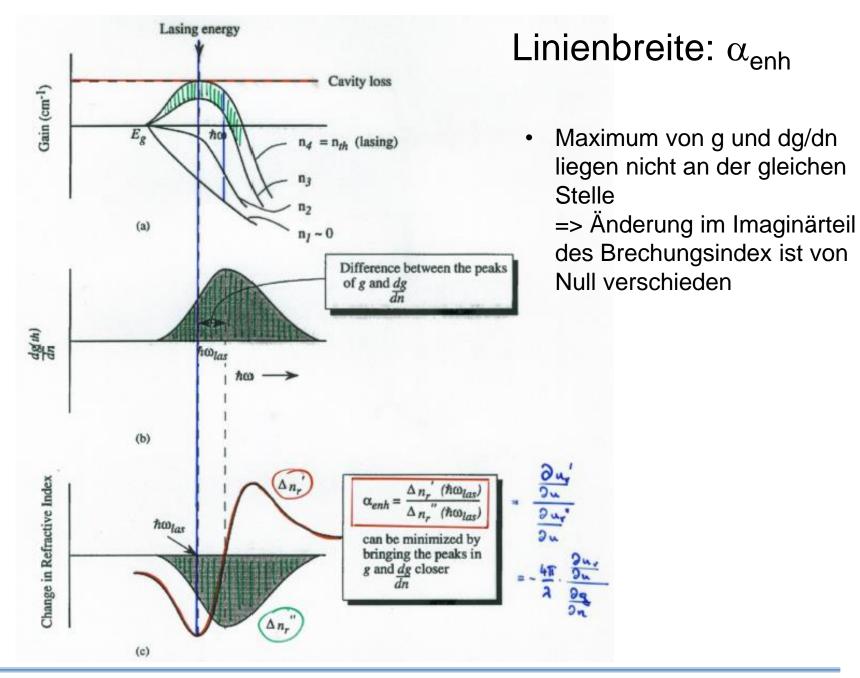
$$\Delta g = -\frac{2\omega}{c} \Delta n_r''$$

- Der Imaginärteil ergibt sich über die Kramers-Kronig-Beziehung
- Man definiert den Linienbreitevergößerungsfaktor (linewidth enhancement factor)

$$\alpha_{enh} = \frac{\Delta n'_r(\hbar \omega_{Las})}{\Delta n''_r(\hbar \omega_{Las})} = \frac{dn'_r/dn}{dn''_r/dn} = -\frac{4\pi}{\lambda_{Las}} \frac{dn'_r/dn}{dg/dn}$$

mit n = Ladungträgerdichte

für kleines α_{enh} braucht man maximales $\frac{dg}{dn}$



Linienbreite: Spontane Emission

 Die spontane Emission addiert willkürlich eine Photon zur stimulierten Emission und ändert damit die Phase. Berücksichtigung dieser Tatsache in den Bilanzgleichungen führt auf folgenden Ausdruck für die Linienbreite:

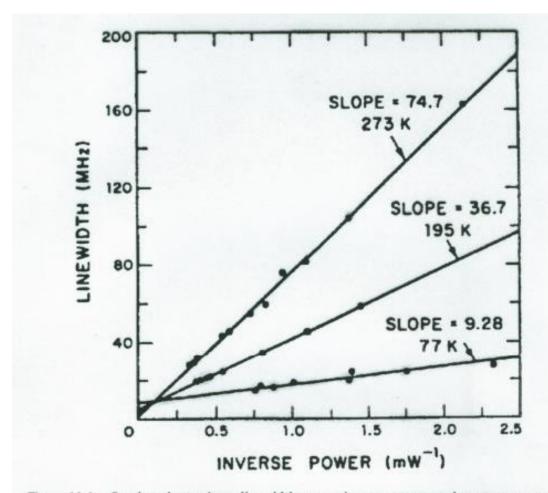
$$\Delta f = \frac{(1 + \alpha_{enh}^2)}{4\pi S} \beta R_{spon}$$

• Für die Ausgangsleistung des Lasers gilt: $P_0 = \frac{1}{2} S \hbar \omega c_r \alpha_m$ mit $c_r = \frac{c}{n_r}$ (Ausbreitungsgeschwindigkeit im Resonator) und $\alpha_m = \frac{1}{L} \ln \frac{1}{R}$ (Spiegelverluste)

Damit lässt sich die Linienbreite wie folgt schreiben:

$$\Delta f = \hbar \omega \frac{c}{n_r} \frac{\ln R}{L} \frac{1}{8\pi} \frac{\beta R_{spon}}{P_0} (1 + \alpha_{enh}^2) \sim \frac{1}{P_0}$$

Linienbreite: Single Mode Laser

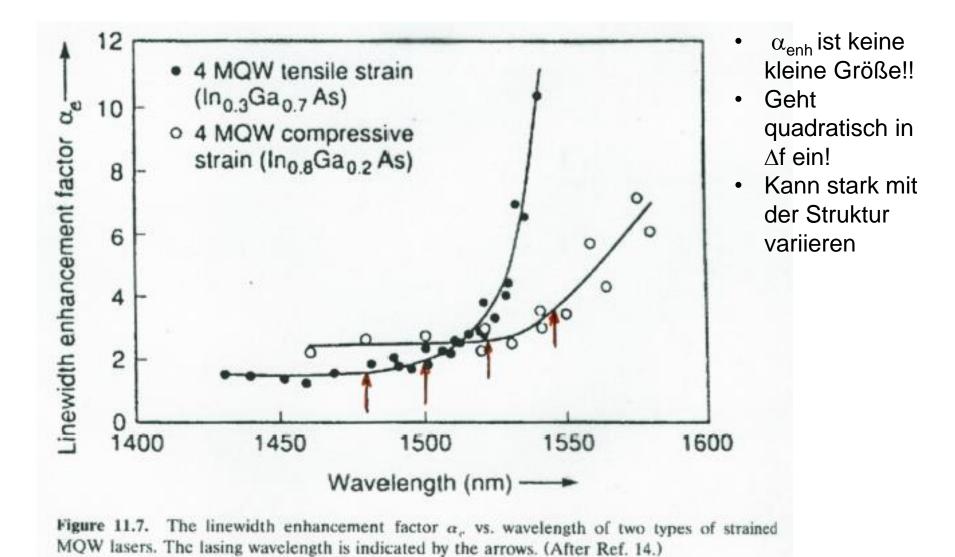


$$\Delta f \sim \frac{1}{P_0}$$

- Temperaturabhängigkeit steckt in α_{enh}
- Für unendliche Leistung sollte die Linienbreite verschwinden
- 50 MHz entsprich 0,16 pm (bei λ =1 μ m)

Figure 11.6. Semiconductor laser linewidth versus inverse power at three temperatures exhibiting the linear behavior. (After Ref. 33.) The magnitude of the large linewidth was explained [29] using the correction factor $1 + \alpha_e^2$ with $\alpha_e = 5$ at room temperature.

Linienbreite: Single Mode Laser

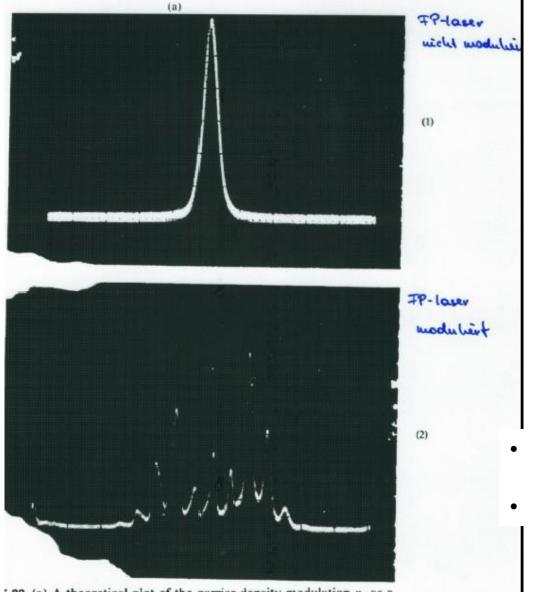


Linienbreite unter Modulation

- Wird ein Laser moduliert, so tendiert das Ausgangsspektrum zur Verbreiterung
- Stärke der Verbreiterung hängt von der Art der Modulation und dem Resonatortyp ab
- Für einen FB-Resonator kann es durch die Modulation dazu kommen, dass mehrere Moden zum Spektrum beitragen
- Bei Monomode-Lasern führt die Modulation zu einer Verbreiterung je nach Modulationsart

$$\Delta f_{chirp} \sim \alpha_{enh}$$
 (Pulse Mode Modulation)

$$\Delta f_{chirp} \sim \frac{I_{\text{mod}}}{P_0} \sqrt{\omega_{\text{m}}^2 + \Gamma_p^2}$$
 (Kleinsignalmodulation)



FB-Laser moduliert

- 550 MHz Modulationsfrequenz
- 1 GHz/Div.

Single-Mode Laser (DFB): Kleinsignalmodulation

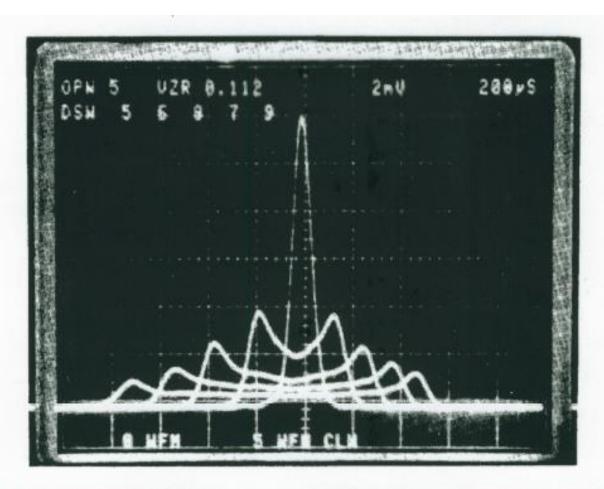
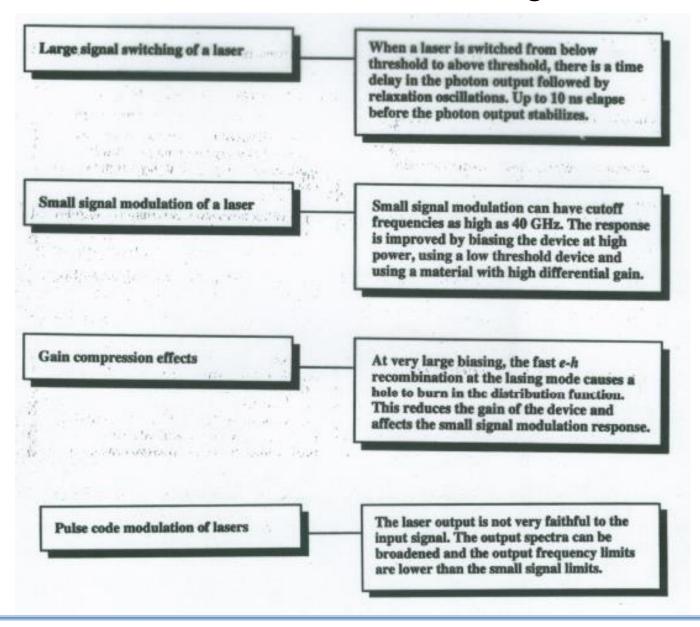


Fig. 6.19 Time-averaged power spectra of a 1.3-μm InGaAsP laser under sinusoidal modulation at 100 MHz. Spectrum broadens with an increase in the modulation current due to frequency chirping. The horizontal scale is 0.5 Å per division. (After Ref. 116)

Zusammenfassung I



Zusammenfassung II

